

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
891**

1987

AMENDEMENT 1

AMENDMENT 1

1992-06

Amendement 1

**Procédures pour les corrections en fonction
de la température et de l'éclairement à appliquer
aux caractéristiques I - V mesurées des
dispositifs photovoltaïques au silicium cristallin**

Amendment 1

**Procedures for temperature and irradiance
corrections to measured I - V characteristics
of crystalline silicon photovoltaic devices**

© CEI 1992 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Comité d'Etudes n° 82 de la CEI: Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
82(BC)33	82(BC)58

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 6

2 Procédures de correction

Ajouter à la définition de I_{MR} :

corrigé, si nécessaire, à la température du dispositif de référence pendant la mesure de I_{MR}

Ajouter, en haut de la page 8, les nouvelles notes suivantes:

4. – Si la température T_R du dispositif de référence pendant une mesure diffère de plus de 2 °C de celle à laquelle il a été étalonné, alors il convient de corriger I_{SR} en température de la manière suivante:

$$I_{SR} = I_{SRO} \alpha_R (T_R - T_O)$$

où:

I_{SRO} est le courant de court-circuit du dispositif de référence à la température à laquelle il a été étalonné

α_R est le coefficient de température du courant du dispositif de référence

5. – α et β sont les coefficients de température du module seul. Si le module est fourni avec une diode en série, il convient que les corrections en température de la tension soient faites en excluant cette diode. Si la diode n'est pas accessible, il convient de fournir ses caractéristiques en fonction de la température.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 82: Solar Photovoltaic Energy Systems.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on Voting
82(CO)33	82(CO)58

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Report indicated in the above table.

Page 7

2 Correction procedures

Add to the definition of I_{MR} :

corrected, as necessary, to the temperature of the reference device during the measurement of I_{MR}

Add, on the top of page 9, the following new notes:

4. – If the temperature, T_R , of the reference device during a measurement differs by more than 2 °C from the temperature at which it was calibrated, I_{SR} should be temperature corrected as follows:

$$I_{SR} = I_{SRO} \alpha_R (T_R - T_O)$$

where:

I_{SRO} is the short circuit current of the reference device at the temperature at which it was calibrated.

α_R is the current temperature coefficient of the reference device.

5. – α and β are temperature coefficients of only the module. If the module is provided with a diode in series, the voltage temperature corrections should be applied excluding this diode. If the diode is not accessible, its characteristics vs. temperature should be provided.

ICS 27.160
